

平成 26 年 9 月 2 日

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 87 回委員会・第 91 回研究会 開催案内

日時：平成 26 年 9 月 26 日（金）

委 員 会：12:00 - 13:00

研 究 会：13:00 - 17:30

場所： 京都大学 東京オフィス
（JR品川駅 徒歩 5 分）

〒108-6027 東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 27 階

TEL: 03-5479-2220 <http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/tokyo-office>

委員会

議 題：

- (1) 前回第 86 回委員会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 92 回研究会以降の研究会について
- (4) ワイドギャップ半導体スクール(10 月 23-25 日)について
- (5) ISSLED2014(12 月 14-19 日)について
- (6) 2015 日独西ワークショップについて
- (7) その他

報告事項：

- (1) 7 月 4 日運営委員会
- (2) 7 月 19 日、8 月 21 日拡大幹事会
- (3) 運営内規、旅費・謝金内規について
- (4) 開催報告：日本結晶成長学会 窒化物半導体結晶成長講演会(7/25-26 開催：名城大学)
- (3) その他

研究会 主 題：「酸化物材料の最近の進展」

「委員長挨拶・企画趣旨説明」(13:00-13:05)

1. 「鉄さび(酸化鉄)半導体の光・電子機能制御」(13:05-13:45)

関 宗俊、田畑 仁（東京大学）

2. 「酸化物半導体 SrTiO₃を用いた電子的急峻界面の設計と放射光評価」(13:45-14:25)

組頭 広志 (高エネルギー加速器研究機構)

3. 「Ga₂O₃基板の光学的特性評価」(14:25-15:05)

尾沼 猛儀^{1,3}、山口 智広²、伊藤 雄三²、本田 徹²、佐々木 公平^{3,4}、

増井 建和⁵、東脇 正高³

(¹東京工業高等専門学校、²工学院大学、³情報通信研究機構、

⁴株式会社 タムラ製作所、⁵株式会社 光波)

休 憩(15:05-15:30)

4. 「Ga₂O₃のエピタキシャル成長技術の現状(仮)」(15:30-16:10)

藤田 静雄 (京都大学)

5. 「酸化物半導体 ZnO および Ga₂O₃の HVPE 成長」(16:10-16:50)

熊谷 義直 (東京農工大学)

6. 「地球上で最もクリーンにできるのは酸化物半導体だと思う」(16:50-17:30)

川崎 雅司 (東京大学)

<追記>

1. 9月26日の委員会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしくをお願いいたします。
3. 準備の都合上、委員会・研究会の出欠回答を9月16日(火)までに日本学術振興会研究事業課 中村 様 (jigyouka04@jpsps.go.jp) 宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。